

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考				
				V _{CB0} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (°C)	I _{CB0} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)											
★ 2SC1181	三洋	RF	Si.EP	40	3	50	300	125	1	35	15~120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1				
" 1182	"	"	"	25	3	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	-1					400*	C _{re} 1				
" 1183																									
★ " 1184	日電	SW	Si.TMe	900	5	1A	50W (T _c =25°C)	150	500	800	60	10	200			t _r <10μS, t _f <3.5μS, t _{sig} <1.5μS							102		
" 1185	"	"	"	300	5	700	50W (T _c =25°C)	150	100	200	90	10	400			t _r <2.5μS, t _f <2μS, t _{sig} <1.5μS							102		
" 1186																									
" 1187	日電	RF	Si.P	40	4	25	250	125	0.1	20	90	10	3	10	-3					700*	0.4	C _c r _{bb} 12pS	138C	フワード AGC	
" 1188	"	"	Si.E	40	4	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	-10					850*	0.5	C _c r _{bb} 9pS	138C		
" 1189	"	"	"	50	4	30	250	125	0.1	20	90	10	10	10	-10					850*	0.5	C _c r _{bb} 9pS	138C		
" 1190	松下	PA	Si.EP	36	4	2.5A	30W (T _c =25°C)	175	100	20	50	13.5	400			P _o =16W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =4W)			600*	17			142		
" 1191	"	"	"	36	4	3.5A	45W (T _c =25°C)	175	0.5mA	20	50	13.5	800			P _o =27W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =8W)			50				143		
" 1192	"	"	"	36	4	5A	60W (T _c =25°C)	175	1mA	20	60	13.5	1A			P _o =37W (f=175MHz, V _{CE} =13.5V, P _i =14W)			350*	100			143		
" 1193	東芝	LN	"	20	2	30	200	175	0.1	10	70	10	10	10	-10	NF=3.5dB PG=11dB (10V, 2mA, 2GHz) (10V, 10mA, 2GHz)				4500*	0.8	20*		140	
" 1194																									
" 1195	東芝	PA.SW	Si.T	200	5	2.5A	100W (T _c =25°C)	150	10	200	30~150	5	1A												102
" 1196	"	PA	Si.EP	60	4.5	750	10W (T _c =25°C)	175	5	15	50	10	1A	10	-150	P _o >3W (f=700MHz, V _{cc} =28V, P _i =1W)			800*	5			135		
" 1197	"	"	"	60	4.5	2A	30W (T _c =25°C)	175	10	15	55	10	1A	10	-150	P _o >9W (f=700MHz, V _{cc} =28V, P _i =3W)			700*	<25			135		
★ " 1198	"	"	"	45	4	3.5A	30W (T _c =25°C)	175	50	15	>20	10	1A	10	-150	P _o =20W (f=700MHz, V _{cc} =28V, P _i =9W)			800*	30			213		
" 1199	"	RF.LN	"	50	3	300	600	150	0.1	20	80	10	20	10	-20	NF=2.5dB (10V, -10mA, 200MHz)				1400*	2.2	C _c r _{bb} 5pS		85B	
" 1200	"	PA	"	40	3.5	180	2.5W (T _c =25°C)	175	1	20	120	5	100	5	-100	P _o =1.05W (f=2GHz, P _i =0.4W, V _{cc} =18V)			1700*	2.3			136		
" 1201																									
" 1202																									
" 1203																									
★ " 1204	日立	RF.AF	Si.EP	30		100	310	125	0.5	18	250	12	2	12	-0.1	130	16.5k	0.7	11	230*	1.8	60*		37A	
★ " 1205	"	RF.Mix Conv.Osc	Si.P	30		100	310	125	0.5	18	120	12	2	12	-2					230*	1.5	C _c r _{bb} 13pS		37A	
★ " 1206	三菱	RF.PA	Si.EP	45	4.5	1.7A	25W (T _c =25°C)	175	1mA	30	50	25	50			P _o =10W (f=770MHz, V _{cc} =25V, P _i =4W)							209		
★ " 1207	"	"	"	45	4.5	3A	30W (T _c =25°C)	175	2mA	30	50	25	50			P _o =16W (f=770MHz, V _{cc} =25V, P _i =7W)							209		
" 1208	"	"	"	36	5	10A	60W (T _c =25°C)	175	2mA	15	50	10	500			P _o =37W, η=70% (f=175MHz, V _{cc} =13.5V, P _i =15W)							127		
" 1209	"	"	"	25	4	700	500	125	1	25	100	1	500	6	-10					150*	15	C _c r _{bb} 100pS	138B	2SA695 とコンプリ	
" 1210	"	"	"	45	4	500	500	125	1	25	100	2	150	6	-10					130*	10	C _c r _{bb} 100pS	138B	2SA696 とコンプリ	